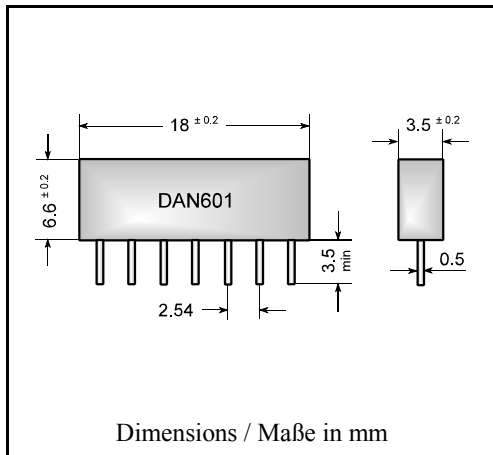


### Small Signal Diode Arrays

### Dioden Sätze mit Allzweckdioden



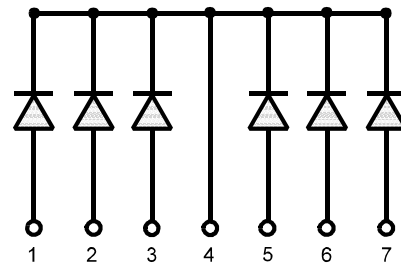
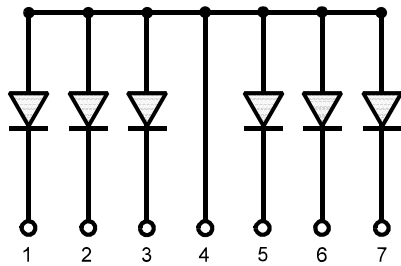
Nominal power dissipation / Nenn-Verlustleistung: 200 mW

Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung: 80 V

7 Pin-Plastic case / 7 Pin-Kunststoffgehäuse: 18 x 3.5 x 6.6 [mm]

Weight approx. – Gewicht ca.: 0.6 g

Standard packaging bulk / Standard Lieferform lose im Karton



"DAP": common anodes / gemeinsame Anoden

"DAN": common cathodes / gemeinsame Kathoden

### Maximum ratings

### Grenzwerte

Type / Typ	Repetitive peak reverse voltage / Periodische Spitzensperrspannung $V_{RRM}$ [V]	Surge peak reverse voltage / Stoßspitzensperrspannung $V_{RSM}$ [V]
DAN 601	80	80
DAP 601	80	80

Max. average forward rectified current, R-load, for one diode operation only per diode for simultaneous operation  
 $T_A = 25^\circ\text{C}$   
 $I_{FAV}$  100 mA <sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  33 mA <sup>1)</sup>

Dauergrenzstrom in Einwegschtung mit R-Last, für eine einzelne Diode pro Diode bei gleichzeitigem Betrieb  
 $T_U = 25^\circ\text{C}$   
 $I_{FAV}$  100 mA <sup>1)</sup>  
 $I_{FAV}$  33 mA <sup>1)</sup>

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave / Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle  
 $T_A = 25^\circ\text{C}$   
 $I_{FSM}$  500 mA

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur	$T_j$	- 50...+150 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	$T_s$	- 50...+150 °C

Characteristics		Kennwerte		
Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 10\text{ mA}$	$V_F$	< 1.0 V <sup>1)</sup>
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = 20\text{ V}$	$I_R$	< 25 nA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to/auf $I_R = 1\text{ mA}$		$t_{rr}$	< 4 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{thA}$	< 85 K/W <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Valid per diode – Gültig pro Diode

<sup>2)</sup> Leads kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten